Взаимодействие пучков тяжелых ионов с электронами плазмы: роль процессов многоэлектронной ионизации

Г. И. Андреев⁺, В. Л. Бычков⁺, В. П. Шевелько^{*1)}

⁺ Физический факультет, кафедра физической электроники, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 119991 Москва, Россия

* Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

Поступила в редакцию 16 февраля 2023 г. После переработки 19 февраля 2023 г. Принята к публикации 19 февраля 2023 г.

Рассмотрены процессы многократной ионизации электронами ионов, находящихся в плазме, и ионов в пучке, проходящего сквозь плазму. На основе экспериментальных данных и теоретических расчетов сечений *п*-электронной ионизации σ_n исследован вклад скоростей многоэлектронной ионизации $\langle v\sigma_n(v)\rangle$ в полную скорость ионизации как функции электронной температуры плазмы T. Показано,что в случае прохождения ионных пучков сквозь плазму, суммарный вклад скоростей многоэлектронной ионизации зации в полную скорость определяется соотношением между скоростью ионного пучка v_P и термальной скоростью электронов в плазме v_{th} . Численные расчеты скоростей многоэлектронной ионизации $\langle v\sigma_n(v) \rangle$ выполнены для ионов W^+ при температурах плазмы T = 1 эВ–10 кэВ и скоростях ионного пучка $v_P = 0-20$ а.е., где атомная единица скорости 1 а.е. $= 2.2 \cdot 10^8$ см/с.

DOI: 10.31857/S123456782306006X, EDN: qsmqxx

1. Введение. Процессы одно- и многоэлектронной (МЭ) ионизации атомов и ионов электронным ударом

$$X^{q+} + e^- \to X^{(q+n)+} + (n+1)e^-, \quad n \ge 1,$$

где *q* – заряд иона, *n* – число выбитых электронов, играют важную роль в кинетике лабораторной и астрофизической плазмы, эволюции зарядового состояния при взаимодействии атомов и ионов с электронным пучком, динамике пучков тяжелых ионов, проходящих сквозь плазменные мишени и других областях [1–3]. Например, при формировании ионизационного равновесия в нестационарной высокотемпературной (лазерной) плазме МЭ процессы $(n \ge 2)$ ответственны за высокотемпературный "хвост" ионизационного распределения, так как многозарядные ионы не успевают образоваться за счет обычной одноэлектронной ступенчатой ионизации. Вклад МЭ ионизации в полное сечение может достигать 30–50 % даже в случае ионизации атомов и ионов при релятивистских энергиях электронов (см.[1]). Особенно существенна МЭ ионизация тяжелых многоэлектронных ионов, имеющих большое число электронных оболочек с близкими значениями энергий связи, поэтому МЭ процессы необходимо учитывать наряду с одноэлектронной ионизацией.

$$\langle v\sigma(v)\rangle = \int_0^\infty v\sigma(v)f(v,T)dv,$$
 (1)

где f(v,T) – функция распределения по скоростям электронов в плазме, T – электронная температура.

В случае максвелловского распределения функция f(v,T) имеет вид:

$$f(v,T) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right), \quad (2)$$

где *т* – масса электрона, *k* – постоянная Больцмана.

Если плазму пересекает пучок ионов со скоростью v_P , то в качестве функции распределения

При взаимодействии пучка ионов с атомами и молекулами остаточного газа ускорителя или с плазменной мишенью, как правило, учитываются только процессы одноэлектронной ионизации налетающих ионов, например, для определения вакуумных условий и времен жизни пучков однозарядных ионов [4] или в методе HIBP (Heavy Ion Beam Probe) диагностики плазмы с помощью тяжелых малозарядных ионов типа Cs⁺, Tl⁺, Au⁺ [5–8]. В методе HIBP регистрируемый ток вторичных ионов пучка существенно зависит от электронной плотности плазмы и скоростей ионизации $\langle v\sigma(v) \rangle$ электронным ударом:

 $^{^{1)}}$ e-mail: shevelkovp@lebedev.ru

используется так называемая "сдвинутая" функция Максвелла, зависящая от скорости пучка v_P [9]:

$$F(v, v_P, T) = \left(\frac{2m}{\pi kT}\right)^{1/2} \frac{v}{v_P} \times \\ \times \exp\left(-\frac{m(v^2 + v_P^2)}{2kT}\right) \sinh\left(\frac{mvv_P}{kT}\right) = \\ = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \frac{v}{v_p} \left[\exp\left(-\frac{m}{2kT}(v - v_p)^2\right) - \\ -\exp\left(-\frac{m}{2kT}(v + v_p)^2\right)\right], \tag{3}$$

где $v = |\mathbf{v}_P - \mathbf{v}_e|$ – скорость ионов в пучке относительно скорости электронов в плазме, $\sinh(x)$ – гиперболический синус. С ростом скорости v_P ширина функции (3) уменьшается, а максимум сдвигается в сторону больших значений v_P , поэтому функцию (3) называют "сдвинутой". Функции распределения (2) и (3) нормированы на единицу:

$$\int_0^\infty f(v,T)dV = \int_0^\infty F(v,v_P,T)dv = 1.$$
 (4)

Метод зондирования НІВР обычно используется для диагностики плазмы в диапазоне температур T = 1 эВ–5 кэВ, а энергия налетающего пучка изменяется в пределах от нескольких сотен кэВ до нескольких МэВ. Учет одно- и двух-электронной скоростей ионизации как функции температуры плазмы выполнен в работах [10, 11] для нескольких отдельных скоростей v_P зондирующих ионов Cs⁺ и Tl⁺ с использованием сдвинутой функции Максвелла.

Настоящая работа посвящена исследованию влияния процессов МЭ ионизации тяжелых ионов электронами плазмы на полные скорости ионизации как функции температуры T и скорости налетающих ионов v_P . Численные расчеты величин $\langle v\sigma(v) \rangle$ выполнены для ионов W⁺ (заряд ядра Z = 74) для температур плазмы T = 1 эВ–10 кэВ и скоростей ионов в пучке $v_P = 0-20$ а.е. Случай $v_P = 0$ соответствует МЭ ионизации ионов, находящихся внутри плазмы.

2. Скорости МЭ ионизации ионов в плазме. Аналитические формулы. Для определения скоростей МЭ ионизации необходимо знание соответствующих сечений в широком диапазоне энергий электронов E. В работе [12] на основе экспериментальных данных и бета-борновской зависимости сечений от энергии получена полуэмпирическая формула для сечений ионизации $n \geq 2$ электронов в виде:

$$\sigma_n = 10^{-18} \, [\text{cm}^2] \frac{a(n) N^{b(n)}}{(I_n/Ry)^2} \left(\frac{u}{u+1}\right)^c \frac{\ln(u+1)}{u+1}$$

Письма в ЖЭТФ том 117 вып. 5-6 2023

$$u = E/I_n - 1, \quad n \ge 2,\tag{5}$$

где u и n – приведенная энергия и число выбитых электронов соответственно, N – полное число электронов мишени, I_n – пороговая энергия ионизации n электронов, 1 Ry = 13.606 эВ. Величины I_n определяются по формуле

$$I_n = \sum_{q'=q}^{q+n-1} I_{q',q'+1},$$
(6)

где $I_{q,q+1}$ – потенциалы однократной ионизации иона $\mathbf{X}^{q+}.$

Параметры аппроксимаций a(n) и b(n) зависят от числа выбитых электронов n, а показатель c = 1.0для нейтральных атомов и c = 0.75 для положительных и отрицательных ионов. Параметры a(n) и b(n)для ионизации $2 \le n \le 10$ электронов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры аппроксимации a(n)
иb(n)для и
онизации $2 \le n \le 10$ электронов атомов и и
онов [12]

n	a(n)	b(n)	n	a(n)	b(n)
2	14.0	1.08	6	0.49	1.96
3	6.30	1.20	7	0.021	2.00
4	0.50	1.73	8	0.0096	2.00
5	0.14	1.85	9	0.0049	2.00
			10	0.0027	2.00



Рис. 1. График функции $e^{-\beta}\Phi(\beta)$ в зависимости от параметра $\beta = I_n/kT$: c = 1 – для атомов, c = 0.75 – для ионов, штриховая кривая – универсальная функция (11)



Рис. 2. Сечения σ_n и скорости $\langle v\sigma_n \rangle$ *п*-электронной ионизации, n = 1-4, ионов W^+ . (a) – Сечения ионизации: символы – эксперимент [13, 14], сплошные кривые – расчет: n = 1, программа АТОМ [15], $n \ge 2$, формула (8), пунктир tot – полное (суммарное) сечение. (b) – соответствующие скорости ионизации с максвелловским распределением (2) как функции температуры электронов, tot – полная скорость ионизации $\langle v\sigma \rangle_{tot}$

Сечение (5) максимально при
$$E_{\max} \approx 4.2I_n$$
:
 $\sigma_{\max} \approx 2.7 \times 10^{-19} \, [\text{см}^2] \frac{a(n)N^{b(n)}}{(I_n/Ry)^2}, \quad E_{\max} \approx 4.2I_n.$
(7)

С сечением (5) и максвелловской функцией распределения (2) скорость МЭ ионизации атомов и ионов, находящихся внутри плазмы, имеет вид:

$$\langle v\sigma_n \rangle = 2.5 \cdot 10^{-10} \, [\mathrm{cm}^3/\mathrm{c}] a(n) N^{b(n)} \left(\frac{\mathrm{Ry}}{I_n}\right)^{3/2} e^{-\beta} \Phi(\beta),$$
$$n \ge 2, \tag{8}$$

$$\geq 2,$$
 (8)

$$\Phi(\beta) = \int_0^\infty \beta^{3/2} \left(\frac{u}{u+1}\right)^c e^{-\beta u} \ln(u+1) du, \quad \beta = \frac{I_n}{kT}.$$
(9)

Скорость МЭ ионизации (8) максимальна при $\beta \approx 0.07$:

$$\langle v\sigma_n \rangle_{\max} \approx 1.24 \times 10^{-10} \, [\mathrm{cm}^3/\mathrm{c}] a(n) N^{b(n)} \left(\frac{\mathrm{Ry}}{I_n}\right)^{3/2},$$

 $\beta \approx 0.07.$ (10)

На рисунке 1 приведены графики функций $e^{-\beta}\Phi(\beta)$ для атомов (c = 1) и ионов (c = 0.75) в зависимости от параметра β . Поскольку отличие функций для атомов и ионов невелико (10–15%), их можно представить в виде одной приближенной функции

$$e^{-\beta}\Phi(\beta) \approx \beta^{1/2} \frac{\ln(1+0.5/\beta)}{1+0.25\beta}, \ \ \beta = \frac{I_n}{kT},$$
 (11)

которая представлена на рисунке 1 пунктирной кривой. Формулы (8)–(11) могут быть использованы для решения задач кинетики плазмы и для оценки вклада процессов многократной ионизации атомов и ионов электронами плазмы.

Ha рисунке 2а представлены сечения n_{-} электронной ионизации, n = 1-4, ионов W^+ (заряд ядра Z = 74, число электронов N = 73) как функции энергии электронов. Экспериментальные сечения σ_n [13, 14] хорошо согласуются с расчетами, выполненными в настоящей работе для n = 1 по программе АТОМ [15] в кулон-борновском приближении с обменом, и для n = 2-4 по формуле (5). Энергии связи электронных оболочек ионов W^+ взяты из работы [16], которые дают пороговые энергии ионизации (в эВ): $I_1 = 16.4, I_2 = 42.4,$ $I_3 = 80.6$ и $I_4 = 132.2$, соответственно. Скорости ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$, вычисленные с маквелловским распределением (2), приведены на рис. 2b.

Письма в ЖЭТФ том 117 вып. 5-6 2023



Рис. 3. Парциальные $\langle v\sigma_n \rangle$ и полные $\langle v\sigma \rangle_{tot}$ скорости МЭ ионизации ионов W^+ , n = 1-4, как функции электронной температуры T при различных скоростях ионного пучка v_P (в а.е.), формулы (1), (3); tot – полная (суммарная) скорость ионизации $\langle v\sigma \rangle_{tot}$

3. Скорости МЭ ионизации ионов в пучке, проходящем сквозь плазму. В этом случае зависимость скоростей ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$ от температуры T определяется соотношением между скоростью ионов v_P и термальной скоростью электронов в плазме v_{th} :

$$v_{th} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.13 \sqrt{\frac{2kT}{m}}.$$
 (12)

При малых скоростях ионов $v_P \to 0 \ (v_P \ll v_{th})$, т.е. при больших температурах

$$T[\Im B] \gg 10(v_P[a.e.])^2,$$
 (13)

сдвинутая функция (3) переходит в "обычную" функцию Максвелла, и скорость ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$ определяется формулами (1) и (2). В противоположном случае $v_p \gg v_{th}$, т.е. в области относительно малых температур

$$T[\Im B] \ll 10(v_P [a.e.])^2,$$
 (14)

функция $F(v, v_p, T)$ переходит в дельта-функцию $F(v, v_p, T) = \delta(v - v_P)$. При этом величины $\langle v\sigma_n \rangle$

Письма в ЖЭТФ том 117 вып. 5-6 2023

практически не зависят от температуры плазмы в области (14) и определяются произведением скорости пучка v_P на эффективное сечение ионизации при этой скорости [17]:

$$\langle v\sigma(v)\rangle \approx v_p \cdot \sigma(v_p), \quad v \approx v_P.$$
 (15)

При $v_P \sim v_{th}$ скорость ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$ определяется общей формулой (1) со сдвинутой функцией Максвелла (3).

На рисунке 3 представлены результаты расчетов скоростей ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$, n = 1-4, ионов W^+ в пучке, проходящем сквозь плазму с температурой T, при скоростях ионного пучка $v_P = 0-10$ а.е. При $v_P = 0$ (рис. 3а) парциальные (n = 1-4), а следовательно, и полные скорости ионизации совпадают с максвелловскими скоростями на рис. 2b при всех значениях температуры плазмы T.

С ростом скорости иона v_P , скорости ионизации $\langle v\sigma_n \rangle$ становятся квази-постоянными величинами, определяемыми уравнением (15), слабо зависящими от температуры плазмы при условии (14). Например, из рис. 3с следует, что при скорости ионов $v_P = 4$ а.е. величины $\langle v\sigma_n \rangle$ квазипостоянны при температурах $T \ll 160$ эВ, а при высоких температурах $T \gg 160$ эВ убывают как максвелловские величины, приведенные на рис. 3а. Из уравнения (15) следует, что в области энергий (14) скорость электрона примерно равна скорости иона $v \approx v_P = 4$ а.е., что соответствует энергии электрона $E \approx \text{Ry}(v_P [\text{a.e.}])^2 \approx$ ≈ 218 эВ. Из рисунка 2а при энергии электрона E == 218 эВ сечения МЭ ионизации для n = 1-4 равны (в ед. 10^{-16} см²): 1.72, 0.40, 0.08 и 0.013, и соответственно произведения $\langle v\sigma_n \rangle$ (в ед. 10^{-7} см³/с): 1.51, 0.35, 0.071, 0.012, что соответствует величинам $\langle v\sigma_n \rangle$ на рис. 3с.

На практике представляет интерес величина вклада МЭ ионизации в полную скорость процесса, т.е.отношение

$$R = \sum_{n>2} \langle v\sigma_n \rangle / \langle v\sigma \rangle_{\text{tot}}.$$
 (16)

Значения R для ионов W^+ при различных скоростях $v_P = 0-20$ а.е. приведены на рис. 4 как функции



Рис. 4. Вклад МЭ ионизации R (%) как функции электронной температуры плазмы T и скорости v_P пучка ионов W^+ , проходящего сквозь плазму, формула (16). Сплошные кривые – расчет для $v_P = 1.25-20$ а.е., пунктирная кривая $v_P = 0$ соответствует вкладу МЭ ионизации при максвелловском распределении электронов (2)

электронной температуры плазмы T. Случай $v_P = 0$ соответствует максвелловской зависимости R от температуры T (рис. 2b), а кривые с $v_P = 0.1$ и $v_P = 0$ в масштабе рисунка практически совпадают. С ростом скорости ионов v_P вклад МЭ процессов увеличивается и при $v_P = 20$ а.е. достигает предельного значения, близкого к максвелловскому $R_{\rm max} \approx 0.36$ при температуре T > 10 кэВ.

При температурах T_e [эВ] $\ll 10 (v_P \text{ [a.e.]})^2$ вклад МЭ ионизации согласно (15) равен

$$R = \sum_{n \ge 2} \langle v_P \sigma_n(v_P) \rangle / \langle v_P \sigma(v_P) \rangle_{\text{tot}} \approx$$
$$\approx \sum_{n \ge 2} \sigma_n(v_P) / \sigma_{\text{tot}}(v_P), \tag{17}$$

т.е. отношению суммы парциальных сечений с $n \geq 2$ к полному сечению ионизации $\sigma_{\rm tot}$ при скорости электрона, равной скорости пучка $v = v_P$ или энергии электрона $E_e \approx v_P^2$ Ry [эВ]. При высоких температурах вклад МЭ ионизации возрастает до предельного значения

$$R_{\max}(v_P) \approx \Sigma_{n \ge 2} \sigma_n(v_P \to \infty) / \sigma_{\text{tot}}(v_P \to \infty), \quad (18)$$

определяемого асимптотикой сечений МЭ ионизации в асимптотической области энергий электронов. Из (18) следует, что

$$\sigma_{\rm tot} = \frac{\sigma_1}{1 - R_{\rm max}}, \quad v_P \to \infty, \tag{19}$$

где σ_1 – сечение одноэлектронной ионизации. Если вклад МЭ ионизации мал, $R_{\max} \to 0$, то полное сечение ионизации $\sigma_{tot} \approx \sigma_1$, однако с ростом R_{\max} отличие σ_{tot} от σ_1 становится существенным, $\sigma_{tot} \gg \sigma_1$, и использование только одноэлектронных сечений σ_1 может привести к значительной погрешности расчетов.

Величина $R_{\rm max}$ зависит от атомной структуры налетающего иона. Для ионов W⁺ получено значение $R_{\rm max} \approx 36\%$, для ионов W²⁺ оценка по экспериментальным данным сечений МЭ ионизации [14] дает $R_{\rm max} \approx 38\%$, для однозарядных ионов O⁺, Rb⁺ и Cs⁺ из экспериментальных данных [18] следует, что $R_{\rm max} \approx 2.0, 20$ и 30%, соответственно. В настоящее время максимальное значение вклада МЭ ионизации в полное сечение $R_{\rm max} \approx 50\%$ (т.е. $\sigma_{\rm tot} \approx 2\sigma_1$) достигнуто в эксперименте [19] для МЭ ионизации нейтральных атомов магния, когда сечения одно- и двух-электронной ионизации в асимптотической области энергий практически равны $\sigma_1 \approx \sigma_2$.

4. Заключение. Исследовано влияние многоэлектронной ионизации на полные скорости ионизации ионов, находящихся внутри плазмы и при прохождении ионного пучка сквозь плазму как функции температуры плазмы T и скорости налетающих ионов v_P . Для ионов в плазме $(v_P = 0)$ получена универсальная формула для величин $\langle v\sigma_n(v) \rangle$ при $n \ge 2$, которая может быть использована для решения ряда задач кинетики плазмы. В случае прохождения ионного пучка сквозь плазму зависимость скоростей ионизации $\langle v\sigma_n(v) \rangle$ от температуры плазмы T и скорости ионного пучка v_P определяется соотношением между величиной v_P и термальной скоростью электронов v_{th} . Показано, что вклад многоэлектронных процессов в полную скорость ионизации растет с ростом скорости ионов v_P , а максимальный вклад равен отношению *сечений* ионизации $\Sigma_{n\geq 2}\sigma_n(v)/\sigma_{tot}(v)$ в асимптотической области энергий электронов.

Численные расчеты скоростей ионизации величин выполнены для ионов W^+ с зарядом ядра Z = 74, однако используемые методы и подходы могут быть применены и для ионов с меньшим зарядом ядра (K^+ , Rb^+ , Cs^+ и т.д.), также используемых в пучковой диагностике современных плазменных установок.

Авторы признательны А.В.Мельникову (НИЦ Курчатовский институт) за полезные замечания.

- V. Shevelko and H. Tawara, Atomic Multielectron Processes, Springer, Berlin (1998).
- M. Hahn, A. Müller, and D.W. Savin, Astrophys. J. 850, 122 (2017).
- V.P. Shevelko, S.N. Andreev, and I.Yu. Tolstikhina, Nucl. Instrum. Methods B 502, 37 (2021).
- А.В. Бутенко, А.Р. Галимов, И.Н. Мешков, Е.М. Сыресин, И.Ю. Толстихина, А.В. Тузиков, А.В. Филиппов, Г.Г. Ходжибагиян, В.П. Шевелько, Письма в ЖЭТФ 113, 784 (2021).
- A. V. Melnikov, *Electric Potential in Toroidal Plasmas*, Springer, Nature Switzerland (2018).
- A. V. Melnikov, I. I. Krupnik, L. G. Eliseev et al. (Collaboration), T-10 Team, and TJ-II Team, Nucl. Fusion 57, 072004 (2017).
- А.В. Мельников, В.А. Вершков, С.А. Грашин, М.А. Драбинский, Л.Г. Елисеев, И.А. Земцов, В.А. Крупин, В.П. Лахин, С.Е. Лысенко,

А.Р. Немец, М.Р. Нургалиев, Н.К. Харчев, Ф.О. Хабанов, Д.А. Шелухин, Письма в ЖЭТФ **115**, 360 (2022).

- Г.А. Саранчаа, Л.Г. Елисеев, А.В. Мельников, Ф.О. Хабанов, Н.К. Харчев, Письма в ЖЭТФ 116, 96 (2022).
- T. Peter and J. Meyer-ter-Vehn, Phys. Rev. A 43, 2015 (1991).
- J.G. Schwelberger and K.A. Connor, IEEE Trans. Plasma Science 22, 418 (1994).
- Ph.O. Khabanov, L.G. Eliseev, A.V. Melnikov, M.A. Drabinskij, C. Hidalgo, N.K. Kharchev, A.A. Chmyga, A.S. Kozachek, I. Pastord, J.L. de Pablos, A. Cappa, and V.P. Shevelko, J. Instrum. 14, C09033 (2019).
- C. Bélenger, P. Defrance, E. Salzborn, V.P. Shevelko, H. Tawara, and D.B. Uskov, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **30**, 2667 (1997).
- M. Stenke, K. Aichele, D. Harthuamani, G. Hofmann, M. Steidl, R. Volpel, and E. Salzbom, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28, 2711 (1995).
- M. Stenke, K. Aichele, D. Harthuamani, G. Hofmann, M. Steidl, R. Volpel, V.P. Shevelko, H. Tawara, and E. Salzborn, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28, 4853 (1995).
- V. P. Shevelko and L. A. Vainshtein, Atomic Physics for Hot Plasmas, Taylor & Francis, N.Y. (1993).
- T. A. Carlson, C. W. Nestor, Jr., N. Wasserman, and J. D. McDowell, At. Data 2, 63 (1970).
- I. Y. Tolstikhina, S. N. Andreev, L. A. Vainshtein, and V. P. Shevelko, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 246, 106944 (2020).
- H. Tawara and M. Kato, *Electron Impact Ionization Data for Atoms and Ions, Preprint NIFS-DATA-51*, Nagoya, Japan (1999).
- P. McCallion, M.B. Shah, and H.B. Gilbody, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25, 1051 (1992).